DEVELOPMENT OF HIGH GRADIENT TRANSVERSE C-BAND DEFLECTING STRUCTURE FOR THE DIAGNOSIS OF TEMPORAL BUNCH STRUCTURE IN THE XFEL/SPRING-8 "SACLA"

Hiroyasu Ego ^{#,A, B)}, Hirokazu Maesaka^{A, B)}, Tatsuyuki Sakurai ^{A, B)}, Yuji Otake^{A, B)}

Tatsuomi Hashirano^{C)}, Sadao Miura^{C)}

^{A)} RIKEN Harima SPring-8 Center

1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo, 679-5148

B) JASRI

1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo, 679-5198

^{C)} Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

1-1-1, Itozaki minami, Mihara, Hiroshima, 729-0393

Abstract

The 8 GeV compact XFEL "SACLA" was constructed in SPring-8 and successfully lased with a wave-length of 1.2 Å after commissioning for three months. A single bunch of electrons is compressed down to about 30 fs in duration and has a peak current of more than 3 kA for the brilliant SASE X-ray radiation. It is crucial for stable lasing to investigate the lasing part in the temporal structure of the bunch. We developed a high gradient C-band deflecting structure named RAIDEN for the temporal diagnosis with a resolution of femtosecond regime. The RAIDEN is a periodically discloaded cylindrical waveguide. The deflecting backward travelling-wave of the dipole HEM11-5 $\pi/6$ mode is excited at 5712 MHz. Each disk has a featuring racetrack-shaped iris. The irises fix the deflecting plane of the HEM11 mode and generate strong cell-to-cell coupling for stable resonance. Two 1.8 m-long RAIDEN were installed in the SACLA and generate a deflection voltage over 40 MV in the vertical direction. We succeeded in diagnosis for a lasing part with a duration of several tens fs in a bunch.

X線自由電子レーザー施設 SACLA における 時間構造診断用高電磁界 Cバンドデフレクターの開発

1. はじめに

SPring-8 X 線自由電子レーザー施設 SACLA (XFEL/SPring-8) は、高電界 C バンドチョーク型 加速管と真空封止アンジュレータによるコンパクト XFEL として建設され、実験ホールを含めた全長は 約 700 m である^[1]。2011 年 3 月末に完成し、3ヶ月 のコミッショニングを経て、世界最短波長の 1.2 Å レーザー発振に成功した^[2]。高強度の安定 X 線レー ザーとして供給すべく、調整運転が継続中で 2011 年度内に供用運転を開始する予定である。

SACLA において X 線レーザーを発振させるには 規格化スライスエミッタンス 1π mm・mrad、ピー ク電流 3 kA 以上、時間にして約 30 fs 長のレーザー 発振部を持つ電子バンチの生成が不可欠である。こ の極短バンチは、複数段のサブハーモニック加速空 胴を用いた断熱的速度変調による電子集群と 3 段の 磁気バンチコンプレッサーによって形成される^[3]。 このバンチ構造を知り、適正にバンチ圧縮を調整す る事は、安定なレーザー発振に必要不可欠である。 我々は fs オーダーのバンチ時間構造を解析するた め、横方向に加速電磁場を発生させる加速管(RF デフレクター)を用いた診断システムを開発した。

このシステムは、ビームエネルギーが 1.4 GeV と なる、3段目バンチコンプレッサー後方にある約 15 m のドリフト領域に設置された。このスペース に測定システムを構築するには 40 MV を超える横 方向偏向電圧を必要としたため、高電磁界Cバンド RF デフレクターを設計した^[4]。この加速管はディス クロード型円筒導波管で、TM11 と TE11 の混成双 極モード(HEM11)後進波の電磁場によりビーム を横方向へキックする。各ディスク中央には、この 加速管を特徴付けるレーストラック型アイリスが設 けられている。レーストラック型アイリスは強いセ ル間結合をもたらすと共に、軸対称性を破る形状で あるため、HEM11 モードの縮退を解き、モードの 偏向面を固定させて安定共振に寄与する。本論文で は RF デフレクターへ課された要求性能と、その解 決手段として開発した C バンド加速管の詳細、及び、 実際のビーム調整で実現された診断性能について述 べる。

[#] ego@spring8.or.jp

2. Cバンド デフレクター "RAIDEN"

電子バンチが RF デフレクター内を通過する際、 横方向偏向電磁場のゼロクロス位相近傍にバンチの 重心を乗せると、重心からの距離にほぼ比例した力 を受け、バンチ前方部とバンチ後方部は逆方向へ キックされる。横方向運動量を得たバンチは RF デ フレクターを抜けてドリフトするにつれて横方向へ 伸張して行き、RF デフレクター下流に設置したプ ロファイルモニター上にビーム進行方向(時間方 向)のバンチ構造が射影される(図1)。モニター 上の射影バンチ長 *I、*重心位置変化*Ay* と偏向電圧 (電場と磁場キックの換算値との和)*V*_Tの関係は次 式で与えられる。

$$l \approx \frac{eV_T L_d}{cp_z} k_a \sigma_z \cdot \cos \varphi_a \tag{1}$$

$$\Delta y \approx \frac{eV_T L_d}{cp_z} \sin \varphi_a \tag{2}$$

ここで、 L_d はデフレクターとモニター間のドリフト 距離、 k_a はデフレクターの波数、 φ_a はゼロクロスか らの位相ずれ、 σ_z はバンチ長、 p_z はバンチの進行方 向運動量を表す。SACLA での設置を考慮してデフ レクターの収納に 5 m 程度、バンチのドリフト長を 5 m とし、バンチ進行方向の時間長 200 fs を射影長 1 mm 以上に伸張して、10 μ m 以下の空間分解能を 持つプロファイルモニターを用いれば、数 fs の分 解能でバンチの時間構造を診断できるようになる。



図1:バンチ時間構造診断システム

S バンド LOLA^[5,6]は FEL 用 RF デフレクターとし て実用化されている加速管である。文献[5]より LOLA の偏向電圧は次式で与えられる。

$$V_T \approx 1.6 \left[MV / m / MW^{1/2} \right] L \sqrt{P_0}$$
 (3)

ここで、Lは LOLA 加速管長、 P_0 は入力パワーを表 す。収納スペースや必要 RF パワーを考慮すると SACLA では LOLA より高い電磁場を発生させる RF デフレクターが必要である。一般に C バンド加速管 は S バンド加速管に比べ、伸張率を上げることがで きるため、C バンド (5712 MHz)を利用したコン パクト高電磁界デフレクターの開発を行った。この 加速管において横方向電圧を 40 MV 以上生成でき れば、必要条件を満足する。また、C バンド大電力 システムが SACLA で開発されており、安定に動作 する 50 MW クライストロン、電源、導波管が、RF デフレクターにも活用可能である^[7]。一方、S バン ドに比べて C バンド加速管のセル結合アイリス (ビーム孔) は小さくなってしまうが、時間構造診 断においてはバンチの重心移動を必要としないため、 C バンド化に伴うアイリスの縮小は致命的な欠陥に ならない。図2に今回開発した C バンドデフレク ターの構造図を表す。この RF デフレクターはディ スクロード型円筒導波管で、レーストラック形状の アイリスを持つのが特徴である。アイリス断面形状 は、半径 Ra の2つの半円と2本の水平方向直線部 La から構成される。我々は、この加速管構造 "racetrack-shaped iris-coupling deflection structure"を 省略して RAIDEN と呼んでいる。



図2:Cバンド デフレクター (RAIDEN)

RAIDEN では、垂直方向に偏向させた HEM11 モード後進波を励起し、通過するバンチを垂直方向 に伸張する。完全軸対称構造体では、HEM11 モー ドは二次の縮退モードである。この縮退を解いて偏 向面の回転を防ぐために、前記の LOLA はビーム軸 から外れた位置に2つの小さなサプレッサー孔を設 けているが、C バンドデフレクターにおいて複数の サプレッサー孔を設けるのは、製造が困難になると 我々は判断した。RAIDEN では軸対称性を破るレー ストラック型アイリスの採用で、この問題を解決し た。このアイリスにより互いに直交する偏向面を持 つ2つの HEM11 モードが現れる。La が水平方向に なるように設置すると垂直方向の偏向面を持つモー ド(y モード)は強いセル間結合を持ち、水平方向 の偏向面を持つモード(x モード)は弱いセル間結 合を持つ。よって y モードのみ、広いパスバンドを 持ち、x モードとのパスバンドの重なり(混合)を 小さくすることができる。図3にシミュレーション コード MAFIA を用いて計算した Ra = 6 mm、La = 8 mm の x、y 両モードのパスバンドを示す。この場 合、大きなセル間移相を持つ y モードは x モードの パスバンドから外れ、高い群速度を持つようになる。 よってこれらの y モードは x モードと混合すること なく、安定に励起することができる。今回、光速比 で約 2.1%の群速度を持つ 5π/6-y モードを採用し、 5712 MHz で共振するように設計した。この場合、

セル長(ディスク間隔)を 21.869 mm と長くできる ため、2 $\pi/3$ モード等での製作に比べてセル数、接 合点数を減じて製造コストの削減が可能となった。 また、開発期間の短縮や製造工程の簡素化を考慮し て、定インピーダンス型 RAIDEN とした。



図3:HEM11モードの分散

図4にHEM115π/6-yモードの電力規格化偏向電 圧と群速度の MAFIA シミュレーション結果を示す。 Laを1 mmに固定して Raを変化させた場合と、Ra を 6 mm に固定して La を変化させた場合を比較す ると Ra を大きくしてセル間結合を高めて群速度を 上げるよりも、アイリスを適切な長さで扁平化する 方が、速い群速度を持つ。また、レーストラック型 アイリスはビーム偏向方向に幅が狭いため、電場を 集中させ、より高い加速勾配を生成することができ る。これは加速空胴にノーズコーンを設けることと 類似している。要求電圧、電力消費量、真空のコン ダクタンス等を考慮して Ra = 6 mm、La = 8 mm の アイリス形状を採用した。この時のシミュレーショ ン性能を表1、電磁場分布を図5に示す。シミュ レーションの結果、RAIDEN の偏向電圧は次式のよ うになる。

$$V_T \approx 4.3 \left[MV / m / MW^{1/2} \right] L_{\sqrt{P_0}}$$
 (4)

ここで、L は RAIDEN の長さを表す。RAIDEN の管 長は、SACLA の C バンド主加速管^[1]とほぼ同じ、 1.8 m とした。その結果、2 本の RAIDEN に 16 MW の RF パワーを投入すると、40 MV を超える偏向電 圧を発生することができる。これは SACLA におけ



図4:電圧と群速度のアイリス形状依存性

る必要性能を十分満足する。また、C バンドクライ ストロンは 50 MW の出力があるため、2 本の RAIDEN を駆動するのに十分な能力を持つ。



図5:HEM11 5π/6-yモード電磁場分布 (赤:電場、青:磁場)

表1:RFデフレクター設計性能

必要横方向偏向電圧	V_T	> 40	MV
運転位相	φ_a	0 or 180	度
バンチ長	σ_{z}	< 200	fs
解析ビームのエネルギー	cp_z	1.4	GeV
共振周波数	f_a	5712	MHz
セル間遷移位相(セル移相)	βD	5π/6	rad
群速度(光速比)	v_g/c	-2.13	%
加速管充満時間	T_f	0.27	μs
無負荷 Q	Q_a	11200	
シャントインピーダンス	r_T	27.7	$M\Omega/m$
加速管タイプ	定インピーダンス型		
共振モード	HEM11		
セル数	77+2 カップラーセル		
加速実効長(加速管長)	L	1706	m
		(1807)	
加速管台数	2 台		台

3. 製作

RAIDEN はクラス1 無酸素銅製で、77 個の加速 セル群と2 個のカップラーセルで構成される。ディ スクとシリンダーが一体となったカップをスタック して加速セル群を形成しており、ディスクの中心に レーストラック型アイリスを設けている。チューニ ング用ディンプリング穴をシリンダー部中央の上下、 計2ヶ所に設けた。アイリス部以外のディスク平坦 部とシリンダー内径部は超精密旋盤による 0.1S 鏡 面加工で仕上げた。アイリスは、ラジアスエンドミ



図6:ディンプリング試行のテストセル

ルを用いたフライスで 1.6S 加工した後、電解研磨 にて表面粗さが 0.5 µm (rms) 以下となる鏡面仕上 げを行った。加速セル群とカップラーセルを真空ろ う付け接合にて一体化し、1号機と2号機の2本の 加速管を製作した。

レーストラック型アイリスのエッジ加工誤差によ る周波数への影響が大きく数 MHz に及んだため、 ろう付け後にディンプリングによるセルチューニン グを行った。図6にディンプリング試行後のテスト セルの写真を示す。HEM11 モードは隣接セル間の 結合が大きく、また、アイリス部に電場が集中する ことから(図5参照)、金属ロッドの挿入によるデ チューニングが困難で、ノーダルシフト法では精密 調整ができなかった。そこで、T. Khabioulline^[8-10]等 が開発したビーズ法を用いてチューニングを行った。 この方法は、ビーズ測定結果で算出した各セルの反 射波成分からセルの散乱係数を求め、チューニング に必要な S₁₁ パラメータ変化量に換算するものであ る。次式に散乱係数と Su との関係を表す。

$$\frac{\left|\Delta S_{11}\right|}{\left|S_{11}^{*}\right|} = \frac{\Re\left[jS_{n}e^{j\theta}\right]C_{n}}{a_{2}}$$
(5)

ここで、ΔS₁₁は n 番目セルからの反射による S₁₁変 化量、S^{*}11はカップラーセルをデチューンしたとき の S₁₁、a₂は2番セルの加速波振幅、S_nはn番目セ ルの散乱係数、Cnはパワー投入口からセルまでの減 衰量を表す。

各セルは接合前に周波数が低くなるように加工し ておき、ネットワークアナライザにて、S₁₁を測定 しながら、この変化量を達成するようにセル押し込 みディンプリングを行った。累積移相誤差 5°以下、



(a)チューニング前

図7:2号機のビーズ測定データ

VSWR 1.1 以下をチューニング目標とした。その結 果を表2に、チューニング前後のビーズ測定結果を 図7に示す。チューニングによってセル移相が揃っ たことがわかる。ディンプリングによる Q 値の低 下は約 12%であった。2 号機はチューニング手法、 調整プログラムを確立させてチューニングできたた め、目標性能を満足した。1号機はプログラム開発 と同時進行であったため、目標より若干劣るが運転 には問題ないレベルである。実測の RF 特性から得 られる偏向電圧 V_Tは設計値(3)式の 93%となった。 製作の詳細は文献[11]を参照されたい。

表2: RAIDEN 実機の RF 特性

	1 号機	2 号機
共振周波数 (28℃、真空换算)	5712.207 MHz	5711.965 MHz
無負荷Q値	8809	8948
実効シャント インピーダンス	20.8 MΩ/m	21.0 MΩ/m
累積移相誤差	$\pm 7.5^{\circ}$	$\pm 2.8^{\circ}$
VSWR	1.12	1.09
減衰パラメータ	0.548	0.539
群速度 (光速比)	-2.14%	-2.14%

製作完了した 2 本の RAIDEN を理化学研究所播 磨研究所内のテストベンチに設置し、大電力 RF 試 験を行った。約 40 時間のエージング試験の後、放 電等のトラブルを起こすこと無く、2本の RAIDEN に対して 50 MW、60 pps、1 µs の定格運転に成功し た。この試験完了後、2010 年 12 月に SACLA 収納 部へ移設し、大電力連続運転を開始した。図8に収 納部内に設置した RAIDEN を示す。後進波管であ るため、RF パワーはビーム下流側カップラーから 上流側へ投入する。大電力試験、及び、エージング の詳細を文献[12]に述べる。



図8:SACLA 収納部内の RAIDEN



(a) RF デフレクターOFF

(b) 圧縮バンチ (*V*_T = 60 MV)



図9: RAIDEN 後方の Ce: YAG スクリーンで観測したビームプロファイル

診断性能 4.

SACLA のコミッショニングにて、バンチの時間 構造診断を本 RF デフレクターシステムにて行った。 デフレクターを通過したバンチを下流側 RAIDEN 端から約 10.6 m 後方に設置した Ce:YAG スクリー ンモニター(空間分解能約3 µm)^[13,14]にて観測し た。バンチは設計通りに垂直方向へ伸張され、その 測定例を図9に示す。図9(a)はデフレクター OFF 時のビーム像、(b) はレーザー発振のため 40 fs 程度に圧縮した像である。この時、 $V_T = 60$ MV で スクリーン上の射影長1 mm あたりの換算バンチ時 間は約50fsである。(c)はバンチ圧縮調整時の像 で $V_T = 19 \text{ MV}$ に下げて測定したものである。

バンチ伸張の換算係数を確認するため、運転 RF 位相と重心位置の相関を測定した。(2)式より運 転 RF 位相(ゼロクロス位相)付近で位相を少し変 化させると伸張バンチ形状に、ほとんど影響を与え ることなく、スクリーン上のバンチ重心が移動する。 図 10 に電圧 22 MV で測定した時の RF 位相変化に 対する重心位置の移動量を示す。測定から得たバン チ伸張係数は、 $V_T = 60 \text{ MV}$ 換算で 53±13 fs/mm と なり、設計値とほぼ一致した。

診断時には位相換算で 0.14° 程度のジッターがあ るため重心位置が上下に揺れるが、射影バンチ形状 への影響は軽微で時間構造解析には問題とならない。



図 10: バンチの重心移動と RF 位相の関係

まとめ 5.

SACLA においてバンチの時間構造解析すること を図り、横方向へのビーム偏向高電磁場を発生する C バンドデフレクターRAIDEN を開発した。製作し た 1.8 m デフレクターは要求性能を発揮し、セル間 ディスクに設けたレーストラック型アイリスがもた らす偏向面の固定、光速比 2.1%の群速度等により HEM11 モードの安定共振が得られ、60 MV の高電 圧運転ができた。これにより、バンチをスクリーン 上に約 50 fs/mm の割合で射影することができ、fs オーダーでのバンチ時間構造解析が可能となった。

謝辞

RF デフレクターの開発にあたり、新竹 積博士、 稲垣隆宏博士から C バンド加速システムに関する多 大なるご協力とアドバイスをいただきました。高エ ネルギー加速器研究機構の紙谷琢哉博士には電解研 磨加工に関する有益な情報と、ご助言を賜りました。 心より感謝いたします。また、理化学研究所 XFEL 研究開発部門の皆様から多くのご支援をいただき、 時間構造診断システムを構築することができました。 深く感謝いたします。

参考文献

- [1] H. Tanaka, "Operation Status of X-ray FEL facility SACLA at SPring-8", PASJ2011, Tsukuba, August 2011. [2] H. Hara et al., "Beam commissioning of SACLA
- accelerator", PASJ2011, Tsukuba, August 2011.
- T. Shintake, EPAC'08, Genoa, June 2006, p. 136. [3]
- [4] H. Ego et al., EPAC'08, Genoa, June 2006, p. 1098.
- [5] R. Akre et al., PAC'01, Chicago, June 2001, p. 2353.
- [6] R. Akre et al., EPAC'02, Paris, June 2002, p. 1882.
- [7] T. Shirasawa et al., PAC'07, Albuquerque, June 2007, p. 2095
- [8] T. Khabiboulline et al., Internal Report DESY M-95-02, 1995.
- [9] T. Khabiboulline et al., PAC'95, Dallas, May 1995, p. 1666.
- [10] K.Watanabe, et al., GLCX-012, January 2005.
- [11] T. Hashirano et al., "Manufacturing of a C-band RF Deflector for XFEL/SPring-8 "SACLA" ", PASJ2011, Tsukuba, August 2011.
- [12] T. Sakurai et al., "High Power Conditioning of C-band RF Deflecting Structure for XFEL/SPring-8 "SACLA" ", PASJ2011, Tsukuba, August 2011.
- [13] K. Yanagida et al., PASJ2009, Tokai, August 2009, p. 448.
- [14] H. Maesaka et al., "Commissioning and Performance of the Beam Monitor System for XFEL/SPring-8 "SACLA" " PASJ2011, Tsukuba, August 2011.